## 科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 13 日現在

機関番号: 1 3 2 0 1				
研究種目: 若手研究(B)				
研究期間: 2012 ~ 2013				
課題番号: 2 4 7 4 0 2 3 1				
研究課題名(和文)世界で初めて合成に成功したSmAs系充填スクッテルダイトの特異な物性の機構の解明				
研究課題名(英文)Study of the novel properties in the Sm-based filled skutterudites				
研究代表者				
·····································				
富山大学・理工学研究部・准教授				
研究者番号:4 0 5 3 5 3 4 0				
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000 円 、(間接経費) 930,000 円				

研究成果の概要(和文): Sm-系充填スクッテルダイト化合物はこれまで特異な物性が報告されてきたが、SmAs系充 填スクッテルダイト化合物は試料育成の困難さから全く報告が無かった。今回、高圧合成法とフラックス法を組み合わ せた世界でも稀な高圧下フラックス法を用いることでSmAs系充填スクッテルダイト化合物SmT4As12(T: Fe, Ru, Os)単 結晶試料の育成に世界で初めて成功し、異方性まで含めた電子・磁気物性測定を行い、これらの充填スクッテルダイト 化合物が多極子転移や局在した4f電子と遍歴したd電子によるフェリ磁性などの特異な物性を示すことを明らかにする ことができた。

研究成果の概要(英文): Recently, Sm-based filled skutterudite compounds show novel features such as heavy fermion behavior and multipole ordering. To realize origin of these behaviors, systematic studies are imp ortant. However, among them, there are no reports for SmAs-based filled skutterudite compounds SmT4As12 (T : Fe, Ru, Os). In this research, We succeeded in growing new Sm4As12 single crystals by flux method under the high pressure. Then, We studied these single crystals by the electronic and magnetic properties such a s resistivity, magnetization, and specific heat including the anisotropy. From these measurements, We clar ified that SmT4As12 show novel properties such multipole ordering and ferrimagnetic between localized 4f-e lectrons and itinerant d-electrons.

研究分野: 数物系科学

科研費の分科・細目:物理学・物性

キーワード: 籠状物質 強相関電子系 充填スクッテルダイト 電子物性 磁気特性

1.研究開始当初の背景

充填スクッテルダイト化合物 RT<sub>4</sub>X<sub>12</sub> (R: 希土類, T: Fe, Ru, Os, X: プニクトゲン)はR イオンが体心立方晶の結晶構造を組み、そ の周りを12個のX原子が20面体のカゴを 作って取り囲むという特徴的な結晶構造を 持つ。そのため、12個のX原子が1個のR イオンとのみ結合し、4f電子と伝導電子が 非常に強く混成する。その結果、これまで は Ce 化合物でしか観測されなかった強相 関電子的な振舞が Pr 系、Sm 系充填スクッ テルダイト化合物で初めて観測された。こ うした特異な振舞は図1に示すように多く の Sm 系充填スクッテルダイト化合物で観 測されている。それだけではなく、例えば SmOs<sub>4</sub>Sb<sub>1</sub>,は高磁場中でも重い電子状態が 維持されることが報告されており、これは 従来の Ce 系重い電子化合物では観測され ていない新たな特異物性である。これは、 Sm 系充填スクッテルダイトの重い電子の 発現機構が従来とは全く異なったものであ る可能性を示唆している。

こうした発現機構を明らかにするために はなるべく多くの Sm 系充填スクッテルダ イトについて系統的に研究を行い、各々の 化合物の重い電子を特徴付ける様々な物性 を明らかにし、共通点や相違点などをまと めていく必要があるが、図 1 に示す様に SmT<sub>4</sub>As<sub>12</sub>は全く物性の報告が無いため、系 統的な研究を行う上で大きな障害となって いた。

	${\rm Fe}$	Ru	Os
Р	重い電子状態、 強磁性 $T_{\rm C}$ = 1.6 K $\gamma$ = 370 mJ/K <sup>2</sup> mol $\Gamma_{\delta}$ ? a=7.8029 Å	金属絶縁体転移、 多極子転移 $T_{\rm MI} = 16 \text{ K}$ $\Gamma_{67}$ a=8.0397  Å	反強磁性 $T_{\rm N} = 4.5~{\rm K}$ $\gamma \sim 100~{\rm mJ/K^2mol}$ $\Gamma_{67}$ a=8.0752 Å
$\mathbf{As}$	?	?	?
Sb	強磁性 $T_{\rm C} = 45 \text{ K}$ $\gamma = 72 \text{ mJ/K}^2 \text{mol}$ $\Gamma_{67}$ $\mathbf{a} = 9.130 \text{ Å}$	a=9.2959 Å	<u>特異な</u> 重い電子状態、 強磁性 $T_{c} \sim 3 K$ $\gamma = 820 mJ/K^{2}mol$ $\Gamma_{c7}$ a=9.3009 Å

図 1: Sm 系充填スクッテルダイトの既知の物性

2.研究の目的

高圧合成法を発展させた高圧フラックス 法を用いることにより、SmT<sub>4</sub>As<sub>12</sub>、及びそ の参照物質LaT<sub>4</sub>As<sub>12</sub>の純良単結晶試料育成 を行い、異方性まで含めた単結晶試料の物 性測定を行うことでSm系充填スクッテル ダイト化合物の特異な物性を明らかにする ことを目的として研究を行う。

## 3.研究の方法

以下に示すように、単結晶育成には従来の

高圧合成法を発展させた高圧下における As 自己フラックス法を用いた。パイロフェライ トの立方体を圧力容器検圧媒体とし、パイロ フェライトに穴を開け、ヒーターとしてグラ ファイトの円柱を、更にその内部に円筒型の 窒化ボロンを試料容器として挿入すること で原料の加圧及び加熱が出来るようになっ ている。窒化ボロンの資料容器内に原料の Sm, T, Asを1:4:20のモル比になるように詰 めた後にグラファイト・パイロフェライトと 共に加圧装置にセットし、4GPa まで加圧を 行う。加圧完了後加熱を行う。加熱について は一度1000 ℃以上に上げ、その後最大で4 日程度かけて徐冷をした後、室温まで急冷・ 減圧をして試料の取り出しを行う。

フラックスの分離はガラス管に真空封入 し、試料部分を~400 °C 程度まで加熱するこ とでフラックスを昇華させることで行った。 こうして得られた試料の大きさはT元素の種 類によって異なっており、特にT=Feでは最 大で~3mm 程度とかなり大きい単結晶試料を 得ることが出来た。

合成に成功した単結晶試料についてはま ず粉末 X 線回折によって結晶構造・格子定数 の同定を行った後に背面ラウエ方を用いて 結晶方位を決定し、必要に応じて放電加工機 で試料の加工を行った。基本物性測定につい ては異方性を含めた電気抵抗測定・磁化測 定・磁場中比熱測定を行った。電気抵抗(p) 測定については自作のクライオスタット、も しくはカンタムデザイン社の PPMS を用いた 直流4端子法測定を用いて0.5K~300Kの温 度範囲、磁化(M)測定はカンタムデザイン社 の MPMS-7 を用いて 2 K~300 Kの温度範囲 及び0T~7Tの磁場範囲、磁場中比熱(C)測 定はカンタムデザイン社の PPMS を用いて 0.5 K~300 Kの温度範囲及び0T~9Tの磁場 範囲で行った。

## 4.研究成果

ρの温度依存性の結果は以下の通りとなっ た。SmFe<sub>4</sub>As<sub>12</sub>は 300 K 付近では温度の減少 と共にpが減少する金属的な振舞を示した。T ~ 50 K 付近に肩を持ち、T<sub>M</sub> = 39 K に明瞭な折 れ曲りを示した。後述の他の物理量による測 定結果からこの折れ曲がりは磁気相転移に よるものであると考えられる。*T<sub>M</sub>*以下でpは 急激に減少し、最低温度近傍では残留抵抗に よる一定値を示した。残留抵抗比(RRR)は ~220 であり、これはこの試料が非常に純良な 単結晶であることを示している。SmFe<sub>4</sub>As<sub>12</sub> のpから LaFe<sub>4</sub>As<sub>12</sub>のpを差し引いくことで電 気抵抗の磁気抵抗成分ρ<sub>m</sub>を抽出したところ、 ~ 200 K 以下でpm ∝ -lnT という特徴的な温度 依存性を示すことが分かった。この温度依存 性は T<sub>M</sub> 直上まで続いており、この振舞は相 転移の前駆現象、もしくは近藤効果によるも のであることを示唆している。SmRu<sub>4</sub>As<sub>12</sub>に おいても 300 K 付近では温度の減少と共にp が減少する金属的な振舞を示す。一方、より

低温では  $T \sim 40$  K で $\rho$ は最小値を示し、40 K 以下では温度の減少に対して $\rho$ が増加に転じ、  $T \sim 10$  K で最大値を持った後  $T_A \sim 2.5$  K で明 瞭な折れ曲りを示した。後述の他の物理量に よる測定結果からこの折れ曲がりは相転移 によるものであると考えられる。最低温度近 傍では一定値を示した。なお、RRR ~ 5 であ った。SmRu<sub>4</sub>As<sub>12</sub> についても、LaRu<sub>4</sub>As<sub>12</sub> の $\rho$ を差し引いくことで電気抵抗の磁気抵抗成 分 $\rho_m$ を抽出したところ、~ 100 K 以下で $\rho_m \propto$ -lnT という特徴的な温度依存性を示すことが 分かった。この温度依存性は~ 20 K まで続い ており、より低温で最大値を持ち減少してい くことから近藤効果によるものであること を強く示唆している。

Mの測定結果は以下の通りとなった。 SmFe<sub>4</sub>As<sub>12</sub>の帯磁率(M/H)の温度依存性は 300K から温度の減少に伴い緩やかに増大し ていき、~40 K で増大が急激になる。その 後、~10 K で飽和傾向を示し、M/H ~ 2.5 emu/mol にまで達した。更に、低温では ZFC と FC でヒステリシスを示した。こうした振 舞は T<sub>M</sub>における転移が強磁性転移であるこ とを示唆している。また、室温付近における M/Hの振舞は単純なキュリー・ワイスの法則 には従っておらず、これは一般に Sm のスピ ン-軌道相互作用に分裂が小さいため、その効 果によるものである可能性がある。なお、M/H では基本的に異方性は存在せず、T<sub>M</sub>以下の低 温でも定性的に同じ振舞をしている。一方で、 Mの磁場依存性については H//<100>, H//<110>は定性的に同じ振る舞いで有り、微 少磁場で急激に M が増大し、飽和傾向を示す 強磁性的な振舞が観測された。一方で、 H//<111>では、低磁場と~2T 近傍の2 段階で 磁場が急激に増大する振舞が観測されてお り、他の2方向とは異なった振舞を示してい る。<br />
いずれの方位においても 7 T では M は飽 和傾向を示しており、異方性は M<sub><111></sub> < M<sub><110></sub> < *M*<111>であった。SmRu<sub>4</sub>As<sub>12</sub> においては *M*/H の温度依存性は 300K から温度の減少に伴い 緩やかに増大していき、その後、~10 K で飽 和傾向を示すが、T<sub>A</sub>近傍で明確に折れ曲がり 増大傾向を示した。この折れ曲がりは電気抵 抗で観測された相転移によるものである可 能性が高い。また、SmFe<sub>4</sub>As<sub>12</sub>と同様に室温 付近においてもキュリー・ワイスの法則には 従わなかった。また、Mの磁場依存性につい ては磁場の増大に伴い M も単調に増大して おり、急激な磁場の増大などは観測されなか った。

Cの測定結果は以下の通りとなった。 SmFe<sub>4</sub>As<sub>12</sub>についてはH//<100>では50K以下 でC/Tは温度の減少と共に減少し、 $T_{\rm M}$  = 39K で相転移に伴う明瞭な異常を示し、その後は T~30K近傍で肩構造を持ち、5K以下で~100 mJ/K<sup>2</sup>molの最小値を示す。39Kで観測され た異常は磁場の増大に伴い高温側にシフト していくと共に急激に抑制されていく。一方 で、H//<111>方向での測定では、0磁場にお

ける振舞は H//<111>と定量的に一致したが 磁場中の測定では特に T<sub>M</sub> 近傍の振舞が大き く異なっており、磁場の増大によって相転移 はほとんど抑制されずに低温側にシフトし ていき、9T では T<sub>M</sub>~33 K で明瞭な異常が観 測された。また、こうした振舞は磁場方向に 非常に敏感であり、わずかでも磁場方向が <111>方向からずれると転移による異常が磁 場によってすぐに抑制され、降温側にシフト していく H//<100>と定性的に一致する振舞 を示す様になった。SmRu<sub>4</sub>As<sub>12</sub>においてはC/T は~100K で最大値を示した後、~80 K 以下で 徐々に減少していき、~4 K で~0.6 J/K<sup>2</sup>mol の 最小値を示した後急激に増大し T<sub>A</sub> = 2.6 K で 相転移による明瞭な異常を示す。T<sub>A</sub>以下で C/T は急激に減少した後、~0.5 K 以下では核 比熱によって上昇していった。T<sub>A</sub>で観測され た異常は磁場の増大によって降温側にシフ トしていき、更に9Tまで異常が明瞭に観測 された。この様な振舞は強磁性転移や反強磁 性転移などの通常の磁気相転移では説明を することが出来ない。SmOs<sub>4</sub>As<sub>12</sub> については C/T は~100 K で最大値を持ち、その後~60 K 以下で温度の減少と共に徐々に減少してい き、~8Kで最低値として~0.5 J/K<sup>2</sup>mol を示し た後 T<sub>C</sub> = 5 K で急激に増大し、相転移に伴う 異常を示した後、急激に減少していく。この 相転移に伴う異常は磁場の増大に伴い次第 にブロードになっていくものの9Tまでほと んど異常が生じる温度は変化しない。 これまでのρ, C, M/H, M の測定結果から以下 を明らかにすることが出来た。SmFe<sub>4</sub>As<sub>12</sub>は 単純な強磁性ではなく H//<111>方向に Sm の 局在モーメントと Fe の遍歴モーメントが反 強磁性的にカップルした反強磁性転移であ る可能性が高い。これは4fモーメントを持た ないLaFe<sub>4</sub>As<sub>12</sub>においてFeに由来する遍歴弱 強磁性転移が観測されていることとコンシ ステントである。SmRu<sub>4</sub>As<sub>12</sub> は磁化に移転医 による顕著な異常が観測されず、また、転移 温度が磁場の増大に伴い増大することから 四極子秩序などの非磁性な多極子秩序によ るものであると考えられる。SmOs<sub>4</sub>As<sub>12</sub>は時 間の都合上 C しか測定が出来なかったが、そ の測定結果は反強磁性転移によるものであ る可能性を示唆している。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 10件)

• T. Gao and K. Nishimura, <u>T. Namiki</u>, and H. Okimoto: J. Appl. Phys. **111** (2012) 013913.

• L. Li, K. Nishimura, W. D. Hutchison, Z. Qian, D. Huo, and <u>T. Namiki</u>: Appl. Phys. Lett. **100** (2012) 152403.

• T. Gao, K. Nishimura, L. Li and <u>T. Namiki</u>, and Y. Isikawa: J. Alloys Compd. **530** (2012) 26.

• L. Li, W. D. Hutchison, D. Huo, <u>T. Namiki</u>, Z. Qian, and K. Nishimura: Scripta Materialia **67** (2012) 237.

· L. Li, H. Guanghui, I. Umehara, D. Huo, T.

Namiki, and K. Nishimura: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 073701.

·L. Li, M. Kadonaga, H. Dexuan, Q. Zhenghong, T. Namiki, and K. Nishimura: Appl. Phys. Lett. 101 (2012) 122401.

• K. Nishimura, W. D. Hutchison, and T. Namiki: J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013) 054708.

· L. Li, T. Namiki, D. Huo, Z Qian, and K. Nishimura: Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 222405. • R. Higashinaka, K. Takeda, T. Namiki, Y. Aoki,

and H. Sato: J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013) 114710. • T. Gao, K. Nishimura, T. Matsumoto, T. Namiki ,and Y. Isikawa: Solid State Commun. 158 (2013) 1.

• Y. Ogawa, H. Sato, M. Watanabe, T. Namiki, S. Tatsuoka, R. Higashinaka, Y. Aoki, K. Kuwahara, J. Yamaura, and Z. Hiroi: J. Phys. Soc. Jpn. 83 (2014) 034710.

[学会発表](計 7件) ・T. Namiki, K. Baba, and K. Nishimura: International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (2014).

 ・並木孝洋、馬場健太、村田優、西村克彦:日 本物理学会 2012 年秋季大会 (2012)。

 ・並木孝洋、馬場健太、村田優、西村克彦:日 本物理学会第68回年次大会(2013)。

• T. Namiki, Y. Murata, and K. Nishimura: International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (2013).

• T. Namiki, Y. Murata, K. Baba, K. Nishimura: International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (2013).

 ・並木孝洋、馬場健太、下條健太、藤井大輔、 西村克彦: 日本物理学会 2013 年秋季大会 (2013).

 ・並木孝洋、馬場健太、雷前坤、西村克彦:日 本物理学会第 69 回年次大会 (2014)。

6.研究組織 (1)研究代表者 並木孝洋(富山大学) 研究者番号: 40535340